

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2013-77011

(P2013-77011A)

(43) 公開日 平成25年4月25日(2013.4.25)

|                                    |                |             |
|------------------------------------|----------------|-------------|
| (51) Int.Cl.                       | F I            | テーマコード (参考) |
| <b>G09F 9/30 (2006.01)</b>         | G09F 9/30 338  | 3K107       |
| <b>H01L 27/32 (2006.01)</b>        | G09F 9/30 365Z | 5C094       |
| <b>H01L 51/50 (2006.01)</b>        | H05B 33/14 A   | 5F110       |
| <b>H05B 33/14 (2006.01)</b>        | H05B 33/14 Z   |             |
| <b>H05B 33/22 (2006.01)</b>        | H05B 33/22 Z   |             |
| 審査請求 有 請求項の数 2 O L (全 21 頁) 最終頁に続く |                |             |

|              |                                     |          |                     |
|--------------|-------------------------------------|----------|---------------------|
| (21) 出願番号    | 特願2012-245356 (P2012-245356)        | (71) 出願人 | 000153878           |
| (22) 出願日     | 平成24年11月7日 (2012.11.7)              |          | 株式会社半導体エネルギー研究所     |
| (62) 分割の表示   | 特願2012-112328 (P2012-112328)<br>の分割 | (72) 発明者 | 山崎 舜平               |
| 原出願日         | 平成15年5月19日 (2003.5.19)              |          | 神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社 |
| (31) 優先権主張番号 | 特願2002-143711 (P2002-143711)        |          | 半導体エネルギー研究所内        |
| (32) 優先日     | 平成14年5月17日 (2002.5.17)              | (72) 発明者 | 高山 徹                |
| (33) 優先権主張国  | 日本国(JP)                             |          | 神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社 |
|              |                                     |          | 半導体エネルギー研究所内        |
|              |                                     | (72) 発明者 | 村上 智史               |
|              |                                     |          | 神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社 |
|              |                                     |          | 半導体エネルギー研究所内        |
|              |                                     | (72) 発明者 | 木村 肇                |
|              |                                     |          | 神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社 |
|              |                                     |          | 半導体エネルギー研究所内        |
|              |                                     |          | 最終頁に続く              |

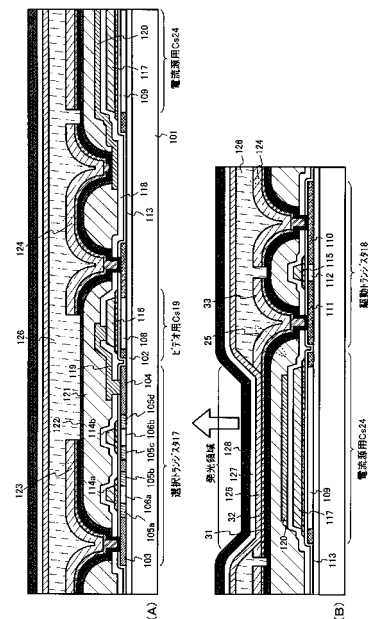
(54) 【発明の名称】 表示装置

(57) 【要約】

【課題】発光素子の劣化を極力抑えるための構造を提供すると共に、各画素に必要とされる容量素子（コンデンサ）を十分に確保するための構造を提供する。

【解決手段】トランジスタ上に、第1パッシベーション膜、第2の金属層、平坦化膜、バリア膜及び第3の金属層の順に積層され、平坦化膜に設けられた第1開口部の側面がバリア膜に覆われ、第1開口部の内側に第2開口部を有し、かつ、第3の金属層は前記第1開口部及び第2開口部を介して前記半導体に接続され、トランジスタの半導体、ゲート絶縁膜、ゲート電極、第1パッシベーション膜及び前記第2の金属層で積層形成された容量素子を備えたことを特徴とする。

【選択図】 図2



**【特許請求の範囲】****【請求項 1】**

トランジスタ上のパッシベーション膜と、  
前記パッシベーション膜上の平坦化膜と、  
前記平坦化膜上のバリア膜と、  
前記バリア膜上の電極と、を有し、  
前記パッシベーション膜は、第 1 の開口部を有し、  
前記有機樹脂膜は、第 2 の開口部を有し、  
前記バリア膜は、第 3 の開口部を有し、  
前記電極は、前記第 1 の開口部、前記第 2 の開口部、及び前記第 3 の開口部を介して前記トランジスタのソース領域又はドレイン領域の一方と電氣的に接続されていることを特徴とする表示装置。 10

**【請求項 2】**

請求項 2 において、

前記平坦化膜の厚さは  $0.5\ \mu\text{m}$  以上  $3\ \mu\text{m}$  以下であることを特徴とする表示装置。

**【発明の詳細な説明】****【技術分野】****【0001】**

本発明は、半導体素子（代表的にはトランジスタ）をデバイスとして用いた表示装置、特にエレクトロルミネセンス表示装置に代表される発光装置に係る技術分野及び該表示装置を画像表示部に備えた電子機器に係る技術分野に属する。 20

**【背景技術】****【0002】**

近年、基板上にトランジスタ（特に薄膜トランジスタ）を集積化してなる液晶表示装置やエレクトロルミネセンス（Electro Luminescence）表示装置の開発が進んでいる。これらの表示装置は、いずれもガラス基板上に薄膜形成技術を用いてトランジスタを作り込み、そのトランジスタをマトリクス配列された各画素に配置し、画像表示を行う表示装置として機能させることを特徴とする。

**【0003】**

表示装置の画像表示を行う領域（以下、画素部という。）に要求される仕様は様々であるが、まずドット数が多くて高精細であること、各画素の有効表示領域の面積が大きく明るい画像表示が可能なこと、そして、画素部の全域に渡って点欠陥や線欠陥を誘因するような不良がないこと、等が挙げられる。これらの仕様を満たすためには、各画素に配置されるトランジスタの性能が良いことだけでなく、安定したプロセスで歩留まり良くトランジスタを形成できる技術が必要である。 30

**【0004】**

また、エレクトロルミネセンス表示装置の中でも有機エレクトロルミネセンス表示装置は、発光源となる発光素子に有機化合物を用いるため、有機化合物の劣化を抑制するための工夫が信頼性確保にあたって重要課題となる（例えば、特許文献 1 参照。）。即ち、信頼性の高い表示装置を得るためには、作製途中のみならず、完成後の経時劣化までも考慮して信頼性対策を施しておく必要がある。 40

**【先行技術文献】****【特許文献】****【0005】**

【特許文献 1】特開 2001 - 203076 号公報

**【発明の概要】****【発明が解決しようとする課題】****【0006】**

本発明は、エレクトロルミネセンス表示装置に代表される発光装置において、発光素子の劣化を極力抑えるための構造を提供すると共に、各画素に必要とされる容量素子（コン 50

デンサ)を十分に確保するための構造を提供することを課題とする。

【課題を解決するための手段】

【0007】

本発明の要旨は、前掲の課題を解決する手段として、平坦化膜の経時変化による影響を防ぐための手段及び開口率を損なうことなく大きな電荷保持特性を有する手段を備えたことを特徴とする表示装置である。即ち、トランジスタを覆う平坦化膜を窒化シリコン膜等の緻密な絶縁膜で封入することにより、その経時変化(脱ガス等)を防ぎ、さらに多層配線のメリットを活用して積層構造の容量素子を設けることにより、開口率を損なうことなく電荷保持特性の良い容量素子を含む画素を備えたことを特徴とする。

【0008】

なお、ここで発光素子とは、一対の電極(陽極及び陰極)の間に発光体(発光層、キャリア注入層、キャリア輸送層、キャリア阻止層その他の発光に必要な有機化合物もしくは無機化合物を積層してなる積層体を指す。)を設けた素子をいう。例えば、エレクトロルミネセンス素子は、発光素子に該当する。

【0009】

具体的には、本発明は、半導体、該半導体上のゲート絶縁膜、該ゲート絶縁膜上の第1の金属層、前記半導体の上方に設けられた第1パッシベーション膜、該第1パッシベーション膜上の第2の金属層、該第2の金属層上の平坦化膜、該平坦化膜上のバリア膜及び該バリア膜上の第3の金属層を有する表示装置であって、前記平坦化膜に設けられた第1開口部の側面が前記バリア膜に覆われると共に、前記第1開口部の内側に前記ゲート絶縁膜、前記第1パッシベーション膜及び前記バリア膜を含む積層体に設けられた第2開口部を有し、かつ、前記第3の金属層は、前記第1開口部及び第2開口部を介して前記半導体に接続され、前記半導体、前記ゲート絶縁膜及び前記第1の金属層で構成される第1容量素子と、前記第1の金属層、前記第1パッシベーション膜及び前記第2の金属層で構成される第2容量素子とを備えたことを特徴とする。

【0010】

また、上記本発明において、容量素子の構成は、前記半導体、前記ゲート絶縁膜及び前記第1の金属層で構成される第1容量素子と、前記第1の金属層、前記第1パッシベーション膜及び前記第2の金属層で構成される第2容量素子と、前記第2の金属層、前記バリア膜及び前記第3の金属で構成される第3容量素子とを備えたことを特徴とする構成であれば、さらに電荷保持特性を良好なものとすることができる。

【0011】

また、上記本発明において、容量素子の構成は、前記半導体、前記ゲート絶縁膜及び前記第1の金属層で構成される第1容量素子と、前記第1の金属層、前記第1パッシベーション膜、前記バリア膜及び前記第3の金属層で構成される第2容量素子とを備えたことを特徴とするものであっても良い。

【0012】

また、上記本発明において、容量素子の構成は、前記半導体、前記ゲート絶縁膜、前記第1パッシベーション膜、前記バリア膜及び前記第3の金属層で構成される容量素子を備えたことを特徴とするものであっても良い。

【0013】

また、上記本発明において、容量素子の構成は、前記半導体、前記ゲート絶縁膜、前記第1パッシベーション膜及び前記第2の金属層で構成される容量素子を備えたことを特徴とするものであっても良い。

【0014】

また、上記本発明において、容量素子の構成は、前記第1の金属層、前記第1パッシベーション膜及び前記第2の金属層で構成される容量素子を備えたことを特徴とするものであっても良い。

【0015】

以下、本発明の表示装置に係る実施の形態について、図面等を参照しながら詳細な説明

10

20

30

40

50

を行う。

【発明の効果】

【0016】

本発明により、第1に、平坦化膜が第1パッシベーション膜及びバリア膜により封入されているため、平坦化膜からの脱ガス等による経時劣化の問題がなく、信頼性の高い表示装置を得ることができる。また、第2に、容量素子を積層形成することにより少ない面積で大きな容量値を確保できる。また、第3に、図2(B)に示した特殊な構造の画素電極を発光素子の陽極として用いることにより光取り出し効率を高め、輝度が高く明るいエレクトロルミネセンス表示装置とすることができると共に、低消費電力化することにより発光素子の劣化の進行度を抑え、信頼性を高くすることができる。

10

【0017】

以上のように、本発明の表示装置は、多層配線を活用することにより各画素に必要とされる容量値(電荷保持用の容量値)を十分な大きさを確保し、かつ、発光素子の劣化を極力抑えるための構造とすることで信頼性が高く輝度の高い表示装置となる。

【図面の簡単な説明】

【0018】

【図1】表示装置の画素構成を示す上面図及び回路図。

【図2】表示装置のデバイス構成を示す断面図。

【図3】表示装置のデバイス構成を示す断面図。

【図4】表示装置のデバイス構成を示す断面図。

20

【図5】表示装置のデバイス構成を示す断面図。

【図6】表示装置のデバイス構成を示す断面図。

【図7】表示装置のデバイス構成を示す断面図。

【図8】表示装置の画素構成を示す上面図及び回路図。

【図9】表示装置の外観を示す上面図及び断面図。

【図10】電子機器の一例を示す図。

【図11】窒化シリコン膜中の不純物分布を示す図。

【図12】窒化シリコン膜のFT-IR測定結果を示す図。

【図13】窒化シリコン膜の透過率を示す図。

【図14】窒化シリコン膜のC-V特性を示す図。

30

【図15】窒化シリコン膜のC-V特性を示す図。

【図16】窒化シリコン膜を用いたMOS構造の断面図。

【図17】窒化シリコン膜の成膜に用いるスパッタ装置を示す図。

【発明を実施するための形態】

【0019】

〔実施の形態1〕 本実施の形態は、本発明のエレクトロルミネセンス表示装置の一例である。図1において、図1(A)は、エレクトロルミネセンス表示装置の一画素における上面回路図(CAD図面)であり、図1(B)はその回路構成を模式的に現した回路図である。図1(B)に示すエレクトロルミネセンス表示装置の各画素は、信号線11、選択ゲート配線12、電流線13、電源線(定電圧もしくは定電流を供給する配線)14、消去ゲート線15及び電流ゲート線16を有し、各画素には選択トランジスタ17、駆動トランジスタ18、ビデオ用Cs(ビデオ用の容量素子)19、消去トランジスタ20、電流源トランジスタ21、入力トランジスタ22、保持トランジスタ23、電流源用Cs(電流源用の容量素子)24及び発光素子25が設けられている。なお、本実施の形態に示す画素の回路構成については、本出願人による特願2001-289983号明細書に記載されており、本出願人の発明による新規な構成である。

40

【0020】

本実施の形態のエレクトロルミネセンス表示装置の特徴として、光取り出しがトランジスタを形成した基板とは逆向きに行われるため、画素電極(陽極もしくは陰極)の下に如何なる回路を組み込んでも開口率((画素面積に対して実効的な表示領域の占める割合)

50

）の面積を低下させることがないという点である。勿論、本発明の適用は、図１（Ａ）、（Ｂ）に示した構成に限定されるものではなく、他の回路構成への適用は当業者が適宜行えば良い。

#### 【００２１】

次に、図１（Ａ）、（Ｂ）に示したエレクトロルミネセンス表示装置の一画素における代表的な断面構造を図２（Ａ）、（Ｂ）に示す。図２（Ａ）の断面図は、選択トランジスタ１７及び電流源用Ｃｓ（電流源用容量素子）１４の断面図、図２（Ｂ）は、電流源用Ｃｓ２４及び駆動トランジスタ１８の断面図である。

#### 【００２２】

図２（Ａ）において、１０１は基板であり、ガラス基板、セラミック基板、石英基板、シリコン基板もしくはプラスチック基板（プラスチックフィルムを含む。）を用いることができる。また、１０２は窒化酸化シリコン膜、酸化窒化シリコン膜もしくはこれらの積層膜からなる下地膜である。さらに、下地膜１０２の上には、選択トランジスタ１７の活性層となる半導体が設けられ、該活性層は、ソース領域１０３、ドレイン領域１０４、ＬＤＤ領域１０５ａ～１０５ｄ及びチャネル形成領域１０６ａ、１０６ｂを有し、ソース領域１０３とドレイン領域１０４の間に、二つのチャネル形成領域及び四つのＬＤＤ領域を有している。このとき同時に、ビデオ用Ｃｓ１９の下方電極１０８、電流源用Ｃｓ２４の下方電極１０９、駆動トランジスタ１８の活性層を構成するソース領域１１０、ドレイン領域１１１及びチャネル形成領域１１２が形成される。

#### 【００２３】

なお、選択トランジスタ１７のソース領域１０３、ドレイン領域１０４及びＬＤＤ領域１０５ａ～１０５ｄはｎ型不純物領域であり、駆動トランジスタ１８のソース領域１１０及びドレイン領域１１１はｐ型不純物領域である。また、選択トランジスタ１７のチャネル形成領域１０６ａ及び１０６ｂ、駆動トランジスタ１８のチャネル形成領域１１２、ビデオ用Ｃｓ１９の第１電極（下方側電極）１０８並びに電流源用Ｃｓ２４の第１電極（下方側電極）１０９は真性（いわゆるｉ型）の半導体である。

#### 【００２４】

これら半導体上には、酸化シリコン膜、酸化窒化シリコン膜（Ｓｉが２５～３５原子％、酸素が５５～６５原子％、窒素が１～２０原子％、水素が０．１～１０原子％で含まれるシリコン化合物膜をいう。以下、同じ。）、窒化アルミニウム膜、酸化アルミニウム膜、酸化窒化アルミニウム膜もしくはこれらの絶縁膜と窒化シリコン膜との積層膜を用いたゲート絶縁膜１１３が設けられる。ゲート絶縁膜１１３は、選択トランジスタ１７及び駆動トランジスタ１８のゲート絶縁膜として機能すると共に、ビデオ用Ｃｓ１９の誘電体及び電流源用Ｃｓ２４の第１誘電体（下方側誘電体）を兼ねる。

#### 【００２５】

ゲート絶縁膜１１３上には、第１の金属層をパターン加工して、選択トランジスタ１７のゲート電極１１４ａ及び１１４ｂ、駆動トランジスタ１８のゲート電極１１５が設けられる。なお、各ゲート電極は、一層目の電極（窒化タンタル膜）と二層目の電極（タンゲステン膜）の形状が異なり、一層目の電極の方が二層目の電極よりも線幅が広がっている。この特徴の形成方法並びにこのような構造のゲート電極とした理由及び利点等については、本出願人による特開２００２－５７１６２号公報を参照すれば良い。また、ゲート電極の形成と同時に、ビデオ用Ｃｓ１９の第２電極（上方側電極）１１６及び電流源用Ｃｓ２４の第２電極（中間電極）１１７が設けられる。

#### 【００２６】

これらゲート電極及びＣｓ用電極上には、第１パッシベーション膜１１８として、窒化酸化シリコン膜（Ｓｉが２５～３５原子％、酸素が１５～３０原子％、窒素が２０～３５原子％、水素が１５～２５原子％で含まれるシリコン化合物膜をいう。以下、同じ。）もしくはプラズマＣＶＤ法で形成された窒化シリコン膜を０．１～１μｍ（好ましくは、０．２～０．５μｍ）で設ける。この第１パッシベーション膜１１８は、水素を１５～２５原子％の濃度で含むため、加熱による水素供給源として機能させ、活性層となる半導体の

水素終端を行うことができる。また、同時に、電流源用Cs24において、第2誘電体（上方側誘電体）として機能する。

【0027】

第1パッシベーション膜118上には、第2の金属層をパターン加工して、選択トランジスタ17のドレイン配線119及び電流源用Cs24の第3電極（上方側電極）120が設けられる。ドレイン配線119は、選択トランジスタ17のドレイン領域104とビデオ用Cs19の第2電極116とを電氣的に接続する。なお、第2の金属層としては、如何なる金属膜を用いても良いが、低抵抗なアルミニウム膜もしくは銅薄膜（銅合金膜を含む。）を用いることが望ましい。

また、その上に形成される平坦化層119との密着性を考慮することが望ましい。

10

【0028】

これらドレイン配線119及び第3電極120上には、平坦化膜121が0.5～3μm（好ましくは、1～2μm）で設けられる。平坦化膜121としては、スピンコーティング法（塗布法）で形成可能な有機樹脂膜もしくは無機絶縁膜を用いることができる。勿論、CVD法もしくはスパッタ法その他の気相法で形成された無機絶縁膜を研磨（機械的研磨、化学的研磨もしくはこれらを併用したものを含む。）したものであっても良い。本発明の実施にあたっては、プラズマ処理を行わずに済む感光性有機樹脂膜（好ましくはポジ型）を用いると良い。感光性有機樹脂膜（代表的には感光性アクリル膜）は、現像液によるエッチングのみでパターン加工が可能であるため、膜中にプラズマダメージを残すことなく形成できる。

20

【0029】

平坦化膜121は、露光及び現像工程を経て、選択トランジスタ17のソース領域103、駆動トランジスタ18のソース領域110及び111、ビデオ用Cs19の第1電極108（厳密には、第1電極108に隣接して設けられたp型不純物領域）並びに電流源用Cs24の第3電極120の上方に開口部（平坦化膜121に設けられた開口部を、第1開口部という。以下、同じ。）が設けられる。そして、第1開口部の設けられた平坦化膜121を覆うようにバリア膜122が30～100nm（好ましくは40～60nm）で設けられ、前掲の第1開口部の内側においては、該バリア膜122、第1パッシベーション膜118及びゲート絶縁膜113に開口部（これらの絶縁膜に設けられた開口部を、第2開口部という。以下、同じ。）が設けられる。

30

【0030】

ここで特徴的な点は、バリア膜122として、極めて緻密な膜質の窒化シリコン膜を用いる点である。この点については、後述する。

【0031】

また、第1開口部においては、バリア膜122と第1パッシベーション膜118が1～5μm（典型的には2～3μm）の範囲で接しており、そのため、平坦化膜121はバリア膜122と第1パッシベーション膜118によって完全に閉じ込められた状態となっている。その結果、平坦化膜121として有機樹脂膜やスピンオンガラス（SOG）膜を用いたとしても、経時変化による脱ガスの発生を効果的に抑えることができるため、それに起因するトランジスタ特性や発光素子の経時劣化を抑えることができる。

40

【0032】

バリア膜122上には、選択トランジスタ17のソース配線123（図1（B）の信号線11に相当する。）、ビデオ用Cs19の第1電極108と電流源用Cs24の第3電極120とを接続する接続配線124（駆動トランジスタ18のソース配線を兼ねると共に、図1（B）の電源線14に相当する。）及び画素電極125が設けられる。これらの電極は、第1開口部もしくは第2開口部を介してそれぞれ対応する電極へ電氣的に接続される。本実施の形態では、これらの電極を下から順にチタン膜31、窒化チタン膜32、アルミニウム膜（アルミニウム合金膜及び他の元素が添加されたアルミニウム膜を含む。以下、同じ。）33の三層構造としている。その理由として、（1）シリコン膜とのオーミック接触を良好なものとするために最下層はチタン膜が好ましいこと、（2）チタン膜

50

とアルミニウムとの接触抵抗を低減するために窒化チタン膜が好ましいこと、(3)画素電極(発光素子の陽極)として窒化チタン膜を用いることができること、(4)アルミニウム膜の断面を利用して光取り出し効率の向上が期待できること、が挙げられる。

#### 【0033】

本実施の形態では、画素電極125となる電極をチタン膜31、窒化チタン膜32及びアルミニウム膜33で構成しており、発光領域(実効表示領域)において、アルミニウム膜33を選択的に除去して窒化チタン膜32を露出させている。その結果、窒化チタン膜32の表面を発光素子25の陽極として用いることが可能となる。さらに、有機樹脂膜126を用いてアルミニウム膜33をエッチングする際、図2(B)に示すように、アルミニウム膜33の断面形状がテーパ形状となるように調節することで、発光体126を横方向に伝播した光を上方へ反射させ、全体として光の取り出し効率の向上を期待することができる。この反射効果は、画素電極の全周囲で、即ち画素電極の輪郭に沿って効果が得られる。

10

#### 【0034】

なお、発光体(キャリア注入層、キャリア輸送層、キャリア阻止層、発光層その他のキャリアの再結合に寄与する有機化合物もしくは無機化合物またはこれらの積層体を指す。以下、同じ。)126は、陽極(窒化チタン膜)32及び陰極(周期表の1族もしくは2族に属する元素を含む電極を指す。以下、同じ。)127との間に設けられて発光素子25を構成し、発光素子25は第2パッシベーション膜128で保護される。第2パッシベーション膜128は、第1パッシベーション膜118と同一材料でも良いが、バリア膜122と同一である方がより保護機能が高く好ましい。また、発光体126は公知の如何なる材料を用いても良い。

20

#### 【0035】

以上の構成を含む本発明のエレクトロルミネセンス表示装置の画素構成(図1(A))の特徴は、選択ゲート線12、消去ゲート線15及び電流ゲート線16がいずれも同じ層の金属層(第1の金属層)で形成され、信号線11、電流線13及び電源線14がいずれも同じ層の金属層(第2の金属層)で形成されると共に、第1の金属層と第2の金属層が交差する部分については、第2の金属層よりもさらに上層にある第3の金属層を用いて橋渡しする構成にある。

#### 【0036】

即ち、第1の金属層と第2の金属層が交差する場合は、その間に0.1~0.5 $\mu$ m程度の比較的薄い第1パッシベーション膜118しか存在せず寄生容量が形成されてしまうが、第1の金属層と第3の金属層を交差させる場合は、その間に0.5~3 $\mu$ mの厚い平坦化膜121が存在するため寄生容量を殆ど無視することができる。

30

#### 【0037】

また、デバイス構成としての特徴は、まず第1に、平坦化膜121が第1パッシベーション膜118及びバリア膜122により封入されているため、平坦化膜121からの脱ガス等による経時劣化の問題がなく、信頼性の高い表示装置を得ることができる。

#### 【0038】

また、第2に、容量素子を積層形成することにより少ない面積で大きな容量値を確保できる。例えば、電流源用Cs24は、第1電極109、第2電極117及び誘電体(ゲート絶縁膜)113で第1容量素子を構成し、第2電極117、第3電極120及び誘電体(第1パッシベーション膜)118で第2容量素子を構成しており、これらが並列に接続された構成となっている。なお、図示しないが、第1電極109及び第3電極120は固定電位(同電位でも良い。)である。このように、半導体/ゲート絶縁膜/第1の金属層で構成する第1容量素子と第1の金属層/第1パッシベーション膜/第2の金属層で構成する第2容量素子との積層構造の容量素子とすることで、少ない面積で大きな容量値を確保することができる。

40

#### 【0039】

なお、ビデオ用Cs19は、第1電極108、第2電極116及び誘電体(ゲート絶縁

50

膜) 113で容量素子を構成している。このように、積層構造としなくても十分な場合は、二つの電極を用いる容量素子を形成することも可能である。

#### 【0040】

また、第3に、図2(B)に示した特殊な構造の画素電極125を発光素子25の陽極として用いることにより光取り出し効率を高め、輝度が高く明るいエレクトロルミネセンス表示装置とすることができる。なお、輝度が高いということは少ない消費電力で明るい画像が得られるということであり、低消費電力化を図ることができ、さらに、低消費電力化することにより発光素子25の劣化の進行度を抑え、信頼性を高くすることも可能である。

#### 【0041】

以上のように、本実施の形態のエレクトロルミネセンス表示装置は、多層配線を活用することにより各画素に必要とされる容量値(電荷保持用の容量値)を十分な大きさを確保し、かつ、信頼性が高く輝度の高い表示装置となる。

#### 【0042】

(本発明で用いる窒化シリコン膜について)

本発明で用いる窒化シリコン膜は、高周波スパッタ法により形成される極めて緻密な膜質の窒化シリコン膜であり、以下の表1に示すプロセス条件で形成される(代表的な例についても併記した。)。なお、ここで述べる窒化シリコン膜は、本発明において、窒化シリコン膜が用いられる部分すべてに適用可能である。

また、表中の「RFSP-SiN」とは、高周波スパッタ法により形成された窒化シリコン膜を指す。また、「T/S」とは、ターゲットと基板との距離である。

#### 【0043】

【表1】

RFSP-SiNのプロセス条件

|                        | プロセス条件                                             | 代表的例                           | 備考                        |
|------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| ガス                     | N <sub>2</sub> または希ガス/N <sub>2</sub>               | Ar/N <sub>2</sub>              | いずれも純度4N以上                |
| ガス流量比                  | N <sub>2</sub> :30~100%、希ガス:0~70%                  | Ar:N <sub>2</sub> =20:20(sccm) | 希ガスは加熱ガスとして基板裏面から導入しても良い。 |
| 圧力(Pa)                 | 0.1~1.5                                            | 0.8                            |                           |
| 周波数(MHz)               | 13~40                                              | 13.56                          |                           |
| 電力(W/cm <sup>2</sup> ) | 5~20                                               | 16.5                           |                           |
| 基板温度(°C)               | RT(室温)~350                                         | 200                            |                           |
| ターゲット材料                | 単結晶Siインゴットより切り出した材料                                | Si(1~10Ωcm)                    |                           |
| T/S(mm)                | 40~200                                             | 60                             |                           |
| 背圧(Pa)                 | 1×10 <sup>-3</sup> 以下(好ましくは、3×10 <sup>-5</sup> 以下) | 3×10 <sup>-5</sup>             | ターボ分子ポンプまたはクライオポンプ使用      |

#### 【0044】

スパッタガスとして用いるArは、基板を加熱するためのガスとして基板裏面側に吹き付けるように導入され、最終的にN<sub>2</sub>と混合されてスパッタに寄与する。また、表1に示す成膜条件は、代表的な条件であってここに示す数値に限定されるものではなく、成膜されたSiN膜の物性パラメータが後に表4において示す物性パラメータの範囲内に入る限り、実施者が適宜変更しても良い。

#### 【0045】

ここで上記高周波スパッタ法により窒化シリコン膜を成膜するにあたって使用するスパッタ装置の概略図を図17に示す。図17において、30はチャンパー壁、31は磁場を形成するための可動式マグネット、32は単結晶シリコンターゲット、33は防護シャッター、34は被処理基板、36a及び36bはヒーター、37は基板チャック機構、38は防着板、39はバルブ(コンダクタンスバルブもしくはメインバルブ)である。また、

チャンパー壁 30 には、ガス導入管 40、41 は、それぞれ  $N_2$ （もしくは  $N_2$  と希ガスの混合ガス）及び希ガスの導入管である。

【0046】

また、比較例として従来のプラズマ CVD 法により形成される窒化シリコン膜の成膜条件を表 2 に示す。なお、表中の「PCVD-SiN」とは、プラズマ CVD 法により形成された窒化シリコン膜を指す。

【0047】

【表 2】

プラズマCVD条件

|                      | PCVD-SiN                           |
|----------------------|------------------------------------|
| ガス                   | $SiH_4/NH_3/N_2/H_2$               |
| ガス流量 (sccm)          | $SiH_4:NH_3:N_2:H_2=30:240:300:60$ |
| 圧力 (Pa)              | 159                                |
| 周波数 (MHz)            | 13.56                              |
| 電力 ( $W/cm^2$ )      | 0.35                               |
| 基板温度 ( $^{\circ}C$ ) | 325                                |

10

【0048】

次に、表 1 の成膜条件で成膜された窒化シリコン膜と表 2 の成膜条件で成膜された窒化シリコン膜の代表的な物性値（物性パラメータ）について、比較した結果を表 3 にまとめる。なお、「RFSP-SiN (No. 1)」と「RFSP-SiN (No. 2)」との違いは、成膜装置による違いであり、本発明のバリア膜として用いる窒化シリコン膜としての機能を損なうものではない。また、内部応力は、圧縮応力が引っ張り応力かで数値の正負の符号が変わるが、ここでは絶対値のみを取り扱う。

20

【0049】

【表 3】

代表的なSiN物性パラメータの比較

| パラメータ               | 表1の成膜条件によるSiN膜     |                 | 表2の成膜条件によるSiN膜     | 備考                    |
|---------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
|                     | RFSP-SiN (No.1)    | RFSP-SiN (No.2) | PCVD-SiN膜          |                       |
| 比誘電率                | 7.02~9.30          | ←               | ~7                 |                       |
| 屈折率                 | 1.91~2.13          | ←               | 2.0~2.1            | 波長632.8nm             |
| 内部応力 ( $dyn/cm^2$ ) | $4.17 \times 10^8$ | ←               | $9.11 \times 10^8$ |                       |
| エッチング速度 (nm/min)    | 0.77~1.31          | 1~8.6           | ~30                | LAL500、20 $^{\circ}C$ |
| Si濃度 (atomic%)      | 37.3               | 51.5            | 35.0               | RBS                   |
| N濃度 (atomic%)       | 55.9               | 48.5            | 45.0               | RBS                   |
| H濃度 (atoms/cc)      | $4 \times 10^{20}$ | -               | $1 \times 10^{22}$ | SIMS                  |
| O濃度 (atoms/cc)      | $8 \times 10^{20}$ | -               | $3 \times 10^{18}$ | SIMS                  |
| C濃度 (atoms/cc)      | $1 \times 10^{19}$ | -               | $4 \times 10^{17}$ | SIMS                  |

30

【0050】

表 3 に示すように、これら RFSP-SiN (No. 1) 及び RFSP-SiN (No. 2) に共通の特徴点は、PCVD-SiN 膜と比較して、エッチング速度（LAL500 を用いて 20 でエッチングした際のエッチング速度をいう。以下、同じ。）が遅く、水素濃度が低い点が挙げられる。なお、「LAL500」とは、橋本化成株式会社製「LAL500 SA バッファードフッ酸」であり、 $NH_4HF_2$ （7.13%）と  $NH_4F$ （15.4%）の水溶液である。また、内部応力は、プラズマ CVD 法で成膜された窒化シリコン膜よりも絶対値で比較して小さい値となっている。

40

【0051】

ここで本発明者らが表 1 の成膜条件によって成膜した窒化シリコン膜の諸物性のパラメータを表 4 にまとめる。

50

【 0 0 5 2 】

【 表 4 】

本発明に用いるSiNの物性パラメータ

| パラメータ                       | 本発明に用いるSiN膜                                                                            | 備考         |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 比誘電率                        | 7.0~9.5(好ましくは、7.3~7.7)                                                                 |            |
| 屈折率                         | 1.85~2.20(好ましくは、1.90~2.15)                                                             | 波長632.8nm  |
| 内部応力 (dyn/cm <sup>2</sup> ) | 2X10 <sup>10</sup> 以下(好ましくは、5X10 <sup>9</sup> 以下)                                      |            |
| エッチング速度 (nm/min)            | 9以下(好ましくは、0.5~3.5)                                                                     | LAL500、20℃ |
| Si濃度 (atomic%)              | 35~55(好ましくは、37~52)                                                                     | RBS        |
| N濃度 (atomic%)               | 45~60(好ましくは、48~56)                                                                     | RBS        |
| H濃度 (atoms/cc)              | 1X10 <sup>21</sup> 以下(好ましくは、5X10 <sup>20</sup> 以下)                                     | SIMS       |
| O濃度 (atoms/cc)              | 5X10 <sup>18</sup> ~5X10 <sup>21</sup> (好ましくは、1X10 <sup>19</sup> ~1X10 <sup>21</sup> ) | SIMS       |
| C濃度 (atoms/cc)              | 1X10 <sup>18</sup> ~5X10 <sup>19</sup> (好ましくは、1X10 <sup>18</sup> ~2X10 <sup>19</sup> ) | SIMS       |

10

【 0 0 5 3 】

また、当該窒化シリコン膜をSIMS（質量二次イオン分析）により調べた結果を図11に、そのFT-IRの結果を図12に、その透過率を図13に示す。

なお、図13には表2の成膜条件で成膜した窒化シリコン膜についても併せて表記する。透過率については、従来のPCVD-SiN膜と比べて遜色はない。

【 0 0 5 4 】

本発明で用いる窒化シリコン膜においては、表4に示すパラメータを満たす窒化シリコン膜が望ましい。即ち、窒化シリコン膜として、（1）エッチング速度が9nm以下（好ましくは、0.5~3.5nm以下）である窒化シリコン膜を用いること、（2）水素濃度が $1 \times 10^{21} \text{ atoms / cm}^{-3}$ 以下（好ましくは、 $5 \times 10^{20} \text{ atoms / cm}^{-3}$ 以下）であること、（3）水素濃度が $1 \times 10^{21} \text{ atoms / cm}^{-3}$ 以下（好ましくは、 $5 \times 10^{20} \text{ atoms / cm}^{-3}$ 以下）で、かつ、酸素濃度が $5 \times 10^{18} \sim 5 \times 10^{21} \text{ atoms / cm}^{-3}$ （好ましくは、 $1 \times 10^{19} \sim 1 \times 10^{21} \text{ atoms / cm}^{-3}$ ）であること、（4）エッチング速度が9nm以下（好ましくは、0.5~3.5nm以下）で、かつ、水素濃度が $1 \times 10^{21} \text{ atoms / cm}^{-3}$ 以下（好ましくは、 $5 \times 10^{20} \text{ atoms / cm}^{-3}$ 以下）であること、（5）エッチング速度が9nm以下（好ましくは、0.5~3.5nm以下）で、かつ、水素濃度が $1 \times 10^{21} \text{ atoms / cm}^{-3}$ 以下（好ましくは、 $5 \times 10^{20} \text{ atoms / cm}^{-3}$ 以下）で、かつ、酸素濃度が $5 \times 10^{18} \sim 5 \times 10^{21} \text{ atoms / cm}^{-3}$ （好ましくは、 $1 \times 10^{19} \sim 1 \times 10^{21} \text{ atoms / cm}^{-3}$ ）であること、のいずれかを満たすことが望ましい。

20

30

【 0 0 5 5 】

また、内部応力の絶対値は、 $2 \times 10^{10} \text{ dyn / cm}^2$ 以下、好ましくは $5 \times 10^9 \text{ dyn / cm}^2$ 以下、さらに好ましくは $5 \times 10^8 \text{ dyn / cm}^2$ 以下とすると良い。内部応力を小さくすれば、他の膜との界面における準位の発生を低減できる。さらに、内部応力による膜はがれを防止できる。

【 0 0 5 6 】

また、表1の成膜条件による窒化シリコン膜は、Na、Liその他の周期表の1族もしくは2族に属する元素に対するブロック効果効果が極めて強く、これらの可動イオン等の拡散を効果的に抑制することができる。例えば、本発明に用いる陰極としては、アルミニウムに0.2~1.5wt%（好ましくは0.5~1.0wt%）のリチウムを添加した金属膜が電荷注入性その他の点で好適であるが、この場合において、リチウムの拡散によってトランジスタの動作に害を及ぼすことが懸念される。しかしながら、本発明では、バリア膜で完全に保護されることとなるため、リチウムのトランジスタ方向への拡散は気にする必要がない。

40

【 0 0 5 7 】

この事実を示すデータを図14~16に示す。図14は、表2の成膜条件で成膜した窒化シリコン膜（PCVD-SiN膜）を誘電体としたMOS構造のBTストレス試験前後におけるC-V特性の変化を示す図である。試料の構造は、図16（A）に示す通りであり、表面電極にAl-Li（リチウムを添加したアルミニウム）電極を用いることによりリチウム拡散による影響の有無を確かめることができる。図14によれば、BTストレス

50

試験により C - V 特性が大きくシフトし、表面電極からのリチウムの拡散による影響が顕著に現れていることが確認できる。

【 0 0 5 8 】

次に、図 1 5 ( A )、( B ) は、表 1 の成膜条件で成膜した窒化シリコン膜を誘電体とした M O S 構造の B T ストレス試験前後における C - V 特性である。図 1 5 ( A )、( B ) の違いは、図 1 5 ( A ) が表面電極に A l - S i ( シリコンを添加したアルミニウム膜 ) 電極を用いるのに対し、図 1 5 ( B ) が表面電極に A l - L i ( リチウムを添加したアルミニウム膜 ) 電極を用いる点である。なお、図 1 5 ( B ) の結果は、図 1 6 ( B ) に示す M O S 構造の測定結果である。ここで熱酸化膜との積層構造としたのは、窒化シリコン膜とシリコン基板との間の界面準位の影響を低減するためである。

10

【 0 0 5 9 】

図 1 5 ( A )、( B ) の両グラフを比較すると、両グラフともに B T ストレス試験前後における C - V 特性のシフトは殆ど差がなく、リチウム拡散の影響が現れていないこと、即ち、表 1 の成膜条件で成膜した窒化シリコン膜が効果的にブロッキング膜として機能していることが確認できる。

【 0 0 6 0 】

このように、本発明に用いる窒化シリコン膜は、非常に緻密で N a や L i といった可動元素に対するブロッキング効果が高いため、平坦化膜からの脱ガス成分の拡散を抑制すると共に、A l - L i 電極等からの L i 拡散を効果的に抑制することで信頼性の高い表示装置を実現することができる。緻密である理由として、本発明者らは、単結晶シリコンターゲットの表面で薄い窒化シリコン膜が形成され、その窒化シリコン膜が基板へ積層されて成膜されるため、膜中にシリコンクラスタが混入されにくくなった結果として緻密になるのではないかと推測している。

20

【 0 0 6 1 】

また、室温から 2 0 0 程度の低温下のスパッタ法で成膜されるため、本発明のバリア膜として用いる場合のように、樹脂膜の上に成膜できる点においてプラズマ C V D 法よりも有利である。

【 0 0 6 2 】

〔実施の形態 2〕 本実施の形態は、実施の形態 1 とは異なる構成で電流源用 C s を形成した例であり、第 3 の金属層を電極として用いている。なお、その他の構成は、実施の形態 1 と同じであるから、実施の形態 1 の説明を参照すれば良い。従って、本実施の形態では、実施の形態 1 と異なる点のみに着目して説明する。

30

【 0 0 6 3 】

図 3 ( A )、( B ) は、実施の形態 1 における図 2 ( A )、( B ) に相当する図面であり、実施の形態 1 と同じ符号を付してある部分は、実施の形態 1 で説明したものと同一構成を有している。本実施の形態の場合、電流源用 C s 2 6 の構成に特徴があり、図 2 ( A ) において、平坦化層 1 2 1 を除去してある。即ち、第 1 電極 1 0 9、誘電体 ( ゲート絶縁膜 1 1 3 ) 及び第 2 電極 1 1 7 で構成される第 1 の容量素子、第 2 電極 1 1 7、誘電体 ( 第 1 パッシベーション膜 1 1 8 )

及び第 3 電極 1 2 0 で構成される第 2 の容量素子並びに第 3 電極 1 2 0、バリア膜 1 2 2 及び第 4 電極 3 0 1 で構成される第 3 の容量素子の三つの容量素子を積層形成した構成となっている。

40

【 0 0 6 4 】

本実施の形態では、容量素子を三つ形成するために第 1 電極 1 0 9 及び第 3 電極 1 2 0 を固定電位としている。勿論、第 2 電極 1 1 7 及び第 4 電極 3 0 1 を固定電位としても同様である。即ち、交互に固定電位の電極を重ねておくことで最大限に容量を形成することができる。ただし、どの電極を固定電位とするかは回路設計において自由に設定可能であり、前掲の構成に限定する必要はない。

【 0 0 6 5 】

以上の構成を採用すると、三つの容量素子を小さい面積で形成することが可能となるた

50

め、開口率を損失を最小限に抑えつつ大容量を確保することができる。

なお、本実施の形態に示す容量素子の構成は、電流源用Csへの適用に限られるものではなく、ビデオ用Cs19その他の画素内に必要とされる容量素子(Cs)として用いることができる。

【0066】

〔実施の形態3〕 本実施の形態は、実施の形態1とは異なる構成で電流源用Csを形成した例であり、第3の金属層を電極として用いている。なお、その他の構成は、実施の形態1と同じであるから、実施の形態1の説明を参照すれば良い。従って、本実施の形態では、実施の形態1と異なる点のみに着目して説明する。

【0067】

10

図4(A)、(B)は、実施の形態1における図2(A)、(B)に相当する図面であり、実施の形態1と同じ符号を付してある部分は、実施の形態1で説明したものと同一構成を有している。本実施の形態の場合、電流源用Cs28の構成に特徴があり、図2(A)において、平坦化層121及び第3電極120を除去してある。即ち、第1電極109、ゲート絶縁膜113及び第2電極117で構成される第1の容量素子並びに第2電極117、誘電体(第1パッシベーション膜118及びバリア膜122の積層体)及び第4電極401で構成される第2の容量素子の二つの容量素子を積層形成した構成となっている。この場合、誘電体が積層形成されているので、ピンホール等による不良の発生確率が大幅に低減するという利点がある。

【0068】

20

本実施の形態では、容量素子を二つ形成するために第1電極109及び第4電極401を固定電位としている。ただし、どの電極を固定電位とするかは回路設計において自由に設定可能であり、前掲の構成に限定する必要はない。

【0069】

以上の構成を採用すると、二つの容量素子を小さい面積で形成することが可能となるため、開口率を損失を抑えつつ大容量を確保することができる。なお、本実施の形態に示す容量素子の構成は、電流源用Csへの適用に限られるものではなく、ビデオ用Cs19その他の画素内に必要とされる容量素子(Cs)として用いることができる。

【0070】

30

〔実施の形態4〕 本実施の形態は、実施の形態1とは異なる構成で電流源用Csを形成した例であり、第3の金属層を電極として用いている。なお、その他の構成は、実施の形態1と同じであるから、実施の形態1の説明を参照すれば良い。従って、本実施の形態では、実施の形態1と異なる点のみに着目して説明する。

【0071】

40

図5(A)、(B)は、実施の形態1における図2(A)、(B)に相当する図面であり、実施の形態1と同じ符号を付してある部分は、実施の形態1で説明したものと同一構成を有している。本実施の形態の場合、電流源用Cs30の構成に特徴があり、図5(A)において、平坦化層121、第3電極120及び第2電極117を除去してある。即ち、第1電極109、誘電体(ゲート絶縁膜113、第1パッシベーション膜118及びバリア膜122の積層体)及び第4電極501で構成される容量素子となっている。本実施の形態では、第1電極109を固定電位としているが、どの電極を固定電位とするかは回路設計において自由に設定可能であり、前掲の構成に限定する必要はない。また、この場合、誘電体が三層の絶縁膜で積層形成されているので、ピンホール等による不良の発生確率を最小限に抑えることができるという利点がある。

【0072】

また、本実施の形態とした場合、第2電極117が存在しないため第1電極109、即ち半導体には導電型を付与する不純物が添加される。即ち、図1～図4の構成とした場合は、第2電極117に定電圧を印加しないと第1電極109を電極として機能させることができないが、本実施の形態の構成とすると、第4電極501に定電圧を与えなくても常に容量として機能させることができる。この効果は表示装置の消費電力の低減に寄与する

50

。

【 0 0 7 3 】

なお、以上の構成は、電流源用 C s への適用に限られるものではなく、ビデオ用 C s 1 9 その他の画素内に必要とされる容量素子 ( C s ) として用いることもできる。

【 0 0 7 4 】

〔実施の形態 5〕 本実施の形態は、実施の形態 1 とは異なる構成で電流源用 C s を形成した例であり、第 3 の金属層を電極として用いている。なお、その他の構成は、実施の形態 1 と同じであるから、実施の形態 1 の説明を参照すれば良い。従って、本実施の形態では、実施の形態 1 と異なる点のみに着目して説明する。

【 0 0 7 5 】

図 6 ( A )、( B ) は、実施の形態 1 における図 2 ( A )、( B ) に相当する図面であり、実施の形態 1 と同じ符号を付してある部分は、実施の形態 1 で説明したものと同一構成を有している。本実施の形態の場合、電流源用 C s 3 2 の構成に特徴があり、図 2 ( A ) において、第 2 電極 1 1 7 を除去してある。即ち、第 1 電極 1 0 9 が不純物の添加によって電極化しているため、第 3 電極 1 2 0 に定電圧を印加しておかなくても常に電極として機能させることができ、低消費電力化に寄与する。

【 0 0 7 6 】

また、電流源用 C s 3 2 の構成は、第 1 電極 1 0 9、誘電体 ( ゲート絶縁膜 1 1 3 及び第 1 パッシベーション膜 1 1 8 の積層体 ) 及び第 3 電極 1 2 0 で構成される。この場合、誘電体が積層形成されているので、ピンホール等による不良の発生確率が大幅に低減するという利点がある。また、本実施の形態では、第 1 電極 1 0 9 を固定電位としているが、どの電極を固定電位とするかは回路設計において自由に設定可能であり、前掲の構成に限定する必要はない。

【 0 0 7 7 】

なお、以上の構成は、電流源用 C s への適用に限られるものではなく、ビデオ用 C s 1 9 その他の画素内に必要とされる容量素子 ( C s ) として用いることもできる。また、実施の形態 1 ~ 4 のいずれの構成とも組み合わせて実施することが可能である。

【 0 0 7 8 】

〔実施の形態 6〕 本実施の形態は、実施の形態 1 とは異なる構成で電流源用 C s を形成した例であり、第 3 の金属層を電極として用いている。なお、その他の構成は、実施の形態 1 と同じであるから、実施の形態 1 の説明を参照すれば良い。従って、本実施の形態では、実施の形態 1 と異なる点のみに着目して説明する。

【 0 0 7 9 】

図 7 ( A )、( B ) は、実施の形態 1 における図 2 ( A )、( B ) に相当する図面であり、実施の形態 1 と同じ符号を付してある部分は、実施の形態 1 で説明したものと同一構成を有している。本実施の形態の場合、電流源用 C s 3 4 の構成に特徴があり、図 2 ( A ) において、第 1 電極 1 0 9 を除去してある。

【 0 0 8 0 】

また、電流源用 C s 3 4 の構成は、第 2 電極 1 1 7、誘電体 ( 第 1 パッシベーション膜 1 1 8 ) 及び第 3 電極 1 2 0 で構成される。なお、本実施の形態では、第 3 電極 1 2 0 を固定電位としているが、どの電極を固定電位とするかは回路設計において自由に設定可能であり、前掲の構成に限定する必要はない。

【 0 0 8 1 】

なお、以上の構成は、電流源用 C s への適用に限られるものではなく、ビデオ用 C s 1 9 その他の画素内に必要とされる容量素子 ( C s ) として用いることもできる。また、実施の形態 1 ~ 4 のいずれの構成とも組み合わせて実施することが可能である。

【 0 0 8 2 】

〔実施の形態 7〕 本実施の形態は、画素の構成を実施の形態 1 とは異なる構成とした例について、図 8 を用いて説明する。図 8 ( A ) に示す画素構成の特徴は、選択ゲート線 1 2、消去ゲート線 1 5 及び電流ゲート線 1 6 がいずれも同じ層の金属層 ( 第 1 の金属層

10

20

30

40

50

）で形成され、信号線 11、電流線 13 及び電源線 14 がいずれも同じ層の金属層（第 2 の金属層）で形成されると共に、第 1 の金属層と第 2 の金属層が交差する構成となっている点にある。この場合、その間に 0.1 ~ 0.5  $\mu\text{m}$  程度の比較的薄い第 1 パッシベーション膜 118 しか存在せず寄生容量が形成されてしまうが、実施の形態 1 の構成よりもコンタクト数が減少するため、開口率が向上するという利点がある。

【0083】

なお、本実施の形態の画素構成において、画素内には実施の形態 1 ~ 6 に示したいずれの構成の容量素子を形成しても良い。

【0084】

〔実施の形態 8〕 実施の形態 1 ~ 7 に示した薄膜トランジスタの構成はいずれもトップゲート構造（具体的にはプレーナ構造）であるが、各実施の形態では、ボトムゲート構造（具体的には逆スタガ構造）とすることも可能である。その場合、活性層等の半導体層とゲート電極等の第 1 の金属層の位置が逆向きになるだけである。また当然のことながら、薄膜トランジスタに限らず、シリコンウェルを用いて形成された MOS 構造のトランジスタに適用しても良い。

【0085】

〔実施の形態 9〕 実施の形態 1 ~ 8 に示した表示装置は、いずれもエレクトロルミネセンス表示装置を例示しているが、デバイス構成自体は、液晶表示装置に適用する場合についても共通であり、画素電極の構造を変更すれば、液晶表示装置、フィールドエミッション表示装置その他の複数の画素を有する表示装置に適用しても良い。

【0086】

〔実施の形態 10〕 本実施の形態では、本発明を適用しうるエレクトロルミネセンス表示装置の全体の構成について、図 9 を用いて説明する。図 9 は、薄膜トランジスタが形成された素子基板をシーリング材によって封止することによって形成されたエレクトロルミネセンス表示装置の上面図であり、図 9（B）は、図 9（A）の B - B' における断面図、図 9（C）は、図 9（A）の A - A' における断面図である。

【0087】

基板 201 上には、画素部（表示部）202、該画素部 202 を囲むように設けられたデータ線駆動回路 203、ゲート線駆動回路 204a、204b 及び保護回路 205 が配置され、これらを囲むようにしてシール材 206 が設けられている。画素部 202 の構造については、実施の形態 1 ~ 8 及びその説明を参照すれば良い。シーリング材 206 としては、ガラス材、金属材（代表的にはステンレス材）、セラミックス材、プラスチック材（プラスチックフィルムも含む）を用いることができるが、実施の形態 1 ~ 8 に示したように絶縁膜のみで封止することも可能である。

【0088】

このシール材 206 は、データ線駆動回路 203、ゲート線駆動回路 204a、204b 及び保護回路 205 の一部に重畳させて設けても良い。そして、該シール材 206 を用いてシーリング材 207 が設けられ、基板 201、シール材 206 及びシーリング材 207 によって密閉空間 208 が形成される。シーリング材 207 には予め凹部の中に吸湿剤（酸化バリウムもしくは酸化カルシウム等）

209 が設けられ、上記密閉空間 208 の内部において、水分や酸素等を吸着して清浄な雰囲気を保ち、発光体の劣化を抑制する役割を果たす。この凹部は目の細かいメッシュ状のカバー材 210 で覆われており、該カバー材 210 は、空気や水分は通し、吸湿剤 209 は通さない。なお、密閉空間 208 は、窒素もしくはアルゴン等の希ガスで充填しておけばよく、不活性であれば樹脂もしくは液体で充填することも可能である。

【0089】

また、基板 201 上には、データ線駆動回路 203 及びゲート線駆動回路 204a、204b に信号を伝達するための入力端子部 211 が設けられ、該入力端子部 211 へは FPC（フレキシブルプリントサーキット）212 を介してビデオ信号等のデータ信号が伝達される。入力端子部 211 の断面は、図 9（B）の通りであり、ゲート配線もしくはデ

ータ配線と同時に形成された配線からなる入力配線 2 1 3 と F P C 2 1 2 側に設けられた配線 2 1 5 とを、導電体 2 1 6 を分散させた樹脂 2 1 7 を用いて電氣的に接続してある。なお、導電体 2 1 6 としては、球状の高分子化合物に金もしくは銀といったメッキ処理を施したものをを用いれば良い。

【 0 0 9 0 】

また、図 9 ( C ) において、点線で囲まれた領域 2 1 8 の拡大図を図 9 ( D ) に示す。保護回路 2 0 5 は、薄膜トランジスタ 2 1 9 やコンデンサ 2 2 0 を組み合わせて構成すれば良く、コンデンサ 2 2 0 として実施の形態 1 ~ 7 に示した構成の容量素子を用いれば良い。

【 0 0 9 1 】

本実施の形態において、保護回路 2 0 5 は入力端子部 2 1 1 とデータ線駆動回路 2 0 3 との間に設けられ、両者の間に突発的なパルス信号等の静電気が入った際に、該パルス信号を外部へ逃がす役割を果たす。その際、まず瞬間的に入る高電圧の信号をコンデンサ 2 2 0 によって鈍らせ、その他の高電圧を薄膜トランジスタや薄膜ダイオードを用いて構成した回路によって外部へと逃がすことができる。勿論、保護回路は、他の場所、例えば画素部 2 0 2 とデータ線駆動回路 2 0 3 との間や画素部 2 0 2 とゲート線駆動回路 2 0 4 a 、 2 0 4 b の間などに設けても構わない。

【 0 0 9 2 】

以上のように、本実施の形態では、本発明を実施するにあたって、入力端子部に設けられた静電気対策等の保護回路に用いられるコンデンサを同時形成する例を示しており、実施の形態 1 ~ 9 のいずれの構成とも組み合わせて実施することが可能である。

【 0 0 9 3 】

〔実施の形態 1 1〕 本発明の表示装置を表示部に用いた電子機器として、ビデオカメラ、デジタルカメラ、ゴーグル型ディスプレイ（ヘッドマウントディスプレイ）、ナビゲーションシステム、音響再生装置（カーオーディオ、オーディオコンポ等）、ノート型パーソナルコンピュータ、ゲーム機器、携帯情報端末（モバイルコンピュータ、携帯電話、携帯型ゲーム機または電子書籍等）、記録媒体を備えた画像再生装置（具体的には Digital Versatile Disc ( D V D ) 等の記録媒体を再生し、その画像を表示しうるディスプレイを備えた装置）などが挙げられる。それらの電子機器の具体例を図 1 0 に示す。

【 0 0 9 4 】

図 1 0 ( A ) はテレビであり、筐体 2 0 0 1 、支持台 2 0 0 2 、表示部 2 0 0 3 、スピーカー部 2 0 0 4 、ビデオ入力端子 2 0 0 5 等を含む。本発明は表示部 2 0 0 3 に適用することができる。なお、パソコン用、TV 放送受信用、広告表示用などの全ての情報表示用のテレビが含まれる。

【 0 0 9 5 】

図 1 0 ( B ) はデジタルカメラであり、本体 2 1 0 1 、表示部 2 1 0 2 、受像部 2 1 0 3 、操作キー 2 1 0 4 、外部接続ポート 2 1 0 5 、シャッター 2 1 0 6 等を含む。本発明は、表示部 2 1 0 2 に適用することができる。

【 0 0 9 6 】

図 1 0 ( C ) はノート型パーソナルコンピュータであり、本体 2 2 0 1 、筐体 2 2 0 2 、表示部 2 2 0 3 、キーボード 2 2 0 4 、外部接続ポート 2 2 0 5 、ポインティングマウス 2 2 0 6 等を含む。本発明は、表示部 2 2 0 3 に適用することができる。

【 0 0 9 7 】

図 1 0 ( D ) はモバイルコンピュータであり、本体 2 3 0 1 、表示部 2 3 0 2 、スイッチ 2 3 0 3 、操作キー 2 3 0 4 、赤外線ポート 2 3 0 5 等を含む。本発明は、表示部 2 3 0 2 に適用することができる。

【 0 0 9 8 】

図 1 0 ( E ) は記録媒体を備えた携帯型の画像再生装置（具体的には D V D 再生装置）であり、本体 2 4 0 1 、筐体 2 4 0 2 、表示部 A 2 4 0 3 、表示部 B 2 4 0 4 、記録媒体（ D V D 等）読み込み部 2 4 0 5 、操作キー 2 4 0 6 、スピーカー部 2 4 0 7 等を含む。

10

20

30

40

50

表示部 A 2 4 0 3 は主として画像情報を表示し、表示部 B 2 4 0 4 は主として文字情報を表示するが、本発明は表示部 A、B 2 4 0 3、2 4 0 4 に適用することができる。なお、記録媒体を備えた画像再生装置には家庭用ゲーム機器なども含まれる。

#### 【0099】

図 10 (F) はゴーグル型ディスプレイ (ヘッドマウントディスプレイ) であり、本体 2 5 0 1、表示部 2 5 0 2、アーム部 2 5 0 3 を含む。本発明は、表示部 2 5 0 2 に適用することができる。

#### 【0100】

図 10 (G) はビデオカメラであり、本体 2 6 0 1、表示部 2 6 0 2、筐体 2 6 0 3、外部接続ポート 2 6 0 4、リモコン受信部 2 6 0 5、受像部 2 6 0 6、バッテリー 2 6 0 7、音声入力部 2 6 0 8、操作キー 2 6 0 9、接眼部 2 6 1 0 等を含む。本発明は、表示部 2 6 0 2 に適用することができる。

#### 【0101】

図 10 (H) は携帯電話であり、本体 2 7 0 1、筐体 2 7 0 2、表示部 2 7 0 3、音声入力部 2 7 0 4、音声出力部 2 7 0 5、操作キー 2 7 0 6、外部接続ポート 2 7 0 7、アンテナ 2 7 0 8 等を含む。本発明は、表示部 2 7 0 3 に適用することができる。なお、表示部 2 7 0 3 は黒色の背景に白色の文字を表示することで携帯電話の消費電流を抑えることができる。

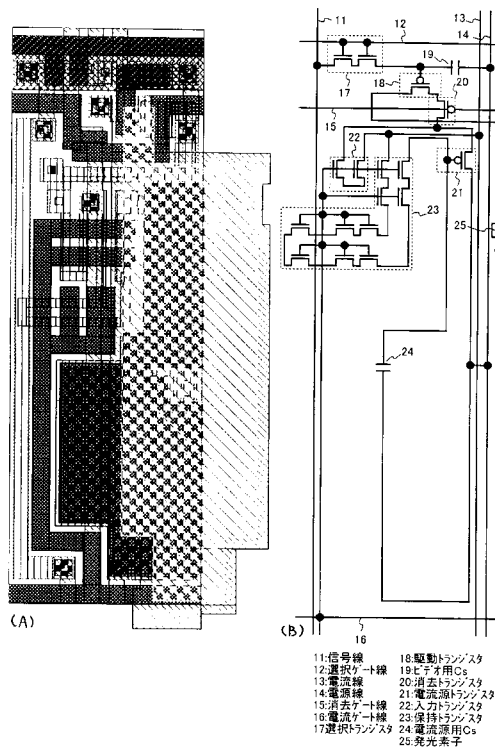
#### 【0102】

以上の様に、本発明を実施して得た表示装置は、あらゆる電子機器の表示部として用いても良い。なお、本実施の形態の電子機器には、実施の形態 1 ~ 9 に示したいずれの構成を有した表示装置を用いても良い。

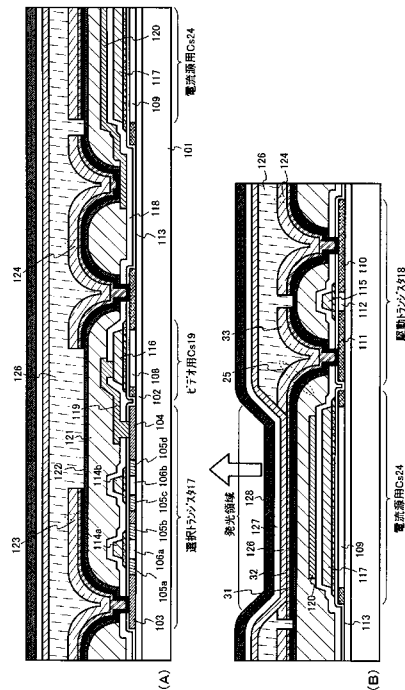
10

20

【図 1】

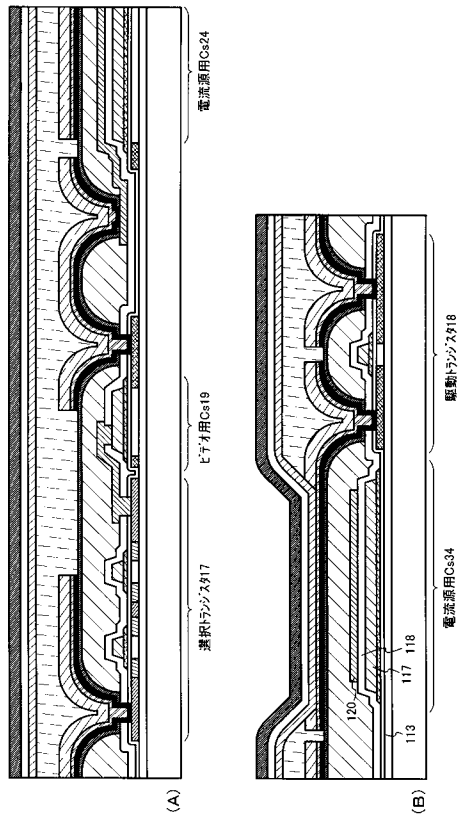


【図 2】

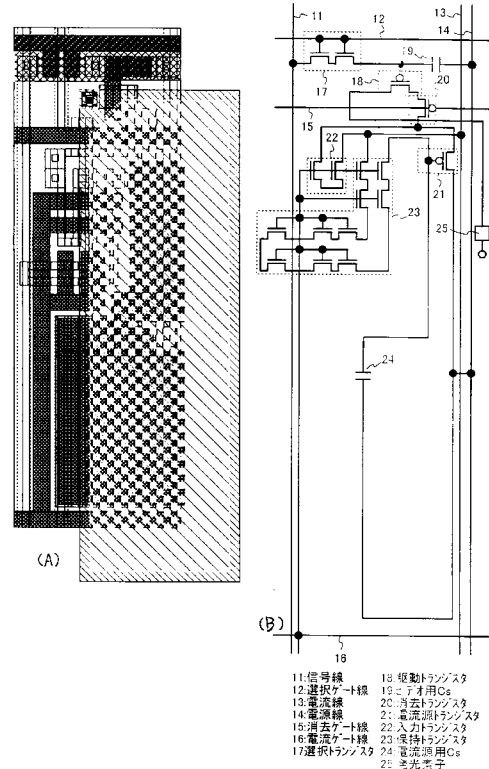




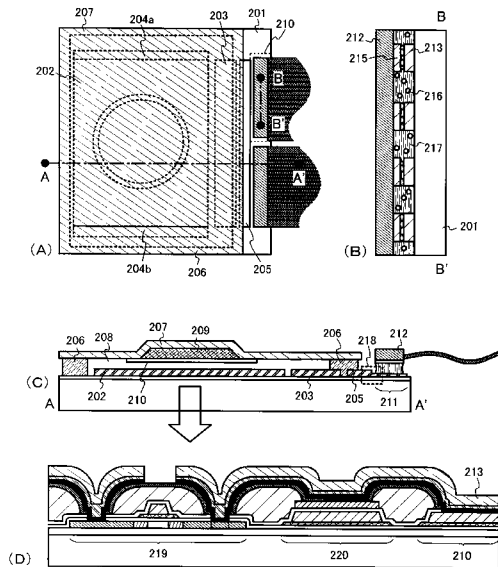
【図 7】



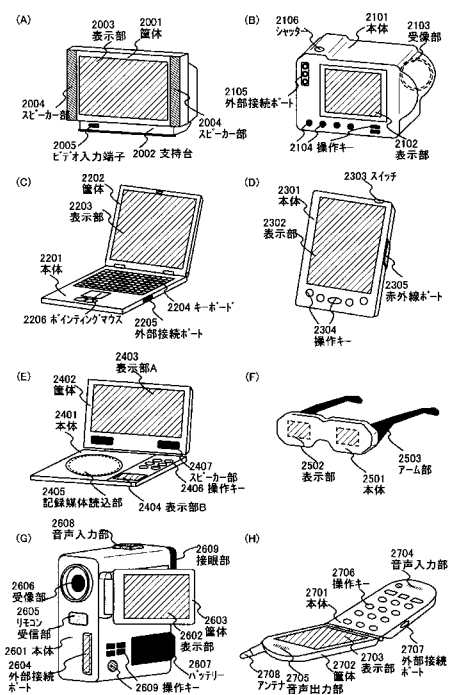
【図 8】



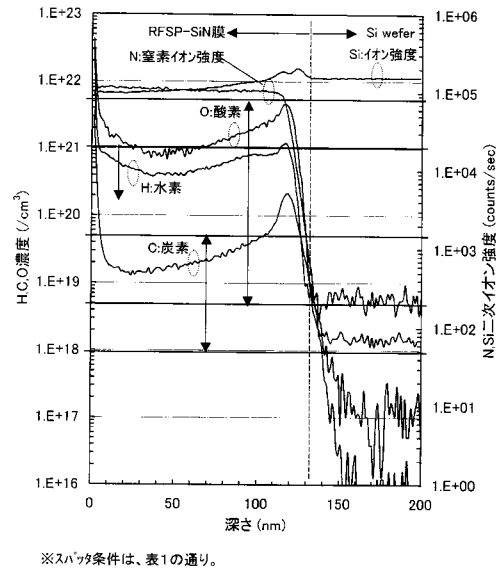
【図 9】



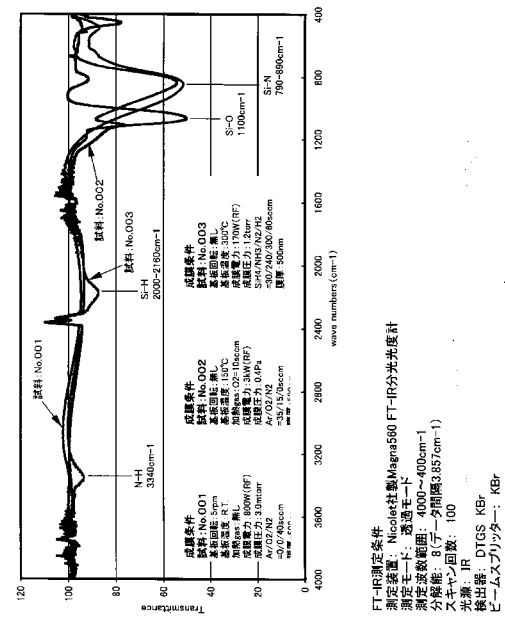
【図 10】



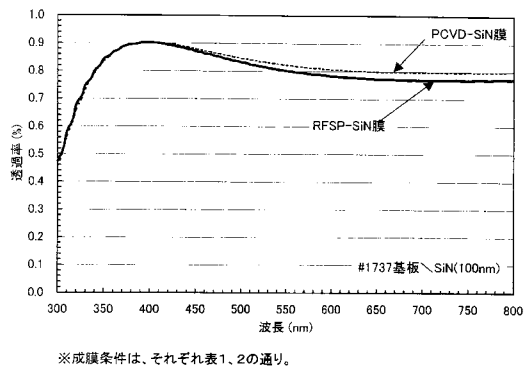
【図 1 1】



【図 1 2】

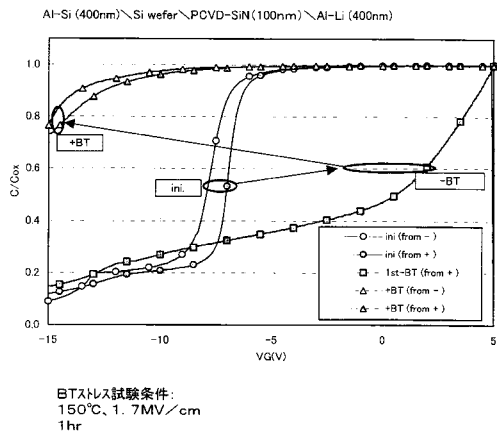


【図 1 3】

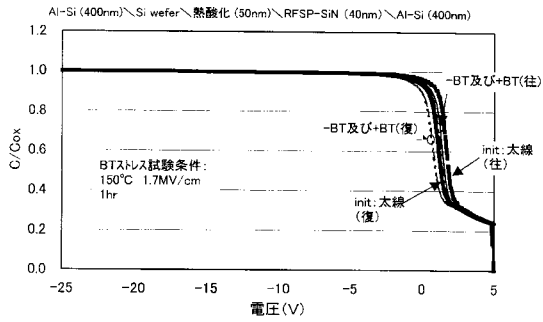


【図 1 4】

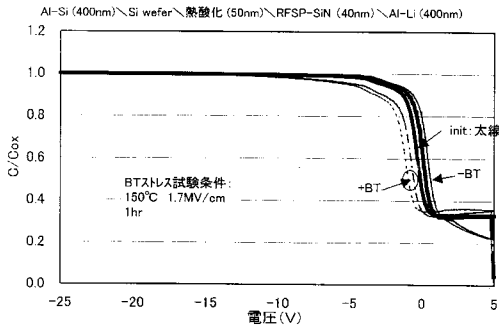
Li拡散源がある場合のMOS構造におけるC-V特性



【図 15】

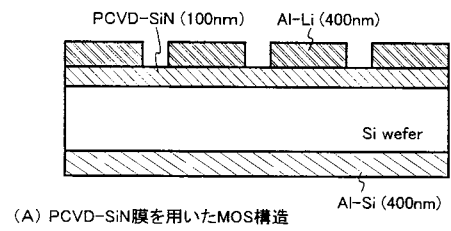


(A) Li拡散源がない場合のMOS構造におけるC-V特性

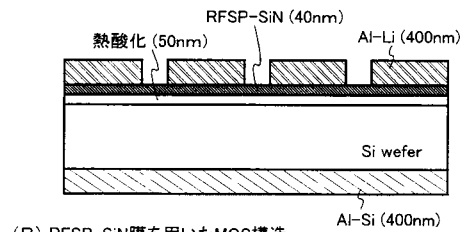


(B) Li拡散源がある場合のMOS構造におけるC-V特性

【図 16】

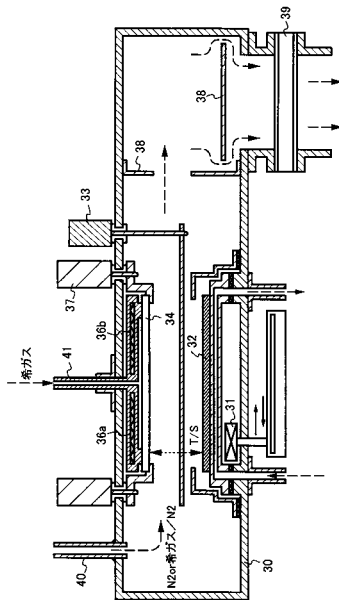


(A) PCVD-SiN膜を用いたMOS構造



(B) RFSP-SiN膜を用いたMOS構造

【図 17】



## フロントページの続き

(51)Int.Cl. F I テーマコード(参考)  
H 0 1 L 21/336 (2006.01) H 0 1 L 29/78 6 1 9 A  
H 0 1 L 29/786 (2006.01)

F ターム(参考) 3K107 AA01 AA05 BB01 BB08 CC21 CC36 DD90 EE03 FF15  
5C094 AA21 AA31 BA03 BA27 BA43 DA13 HA08 JA08  
5F110 AA14 BB01 CC02 DD01 DD02 DD03 DD15 DD17 EE01 EE04  
EE14 EE22 EE23 EE28 FF01 FF02 FF09 GG02 HL02 HL03  
HL12 HM15 HM17 NN02 NN05 NN22 NN23 NN24 NN27 NN28  
NN34 NN35 NN36 NN71 NN72 QQ19 QQ23

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |            |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| 专利名称(译)        | 液晶显示器                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |            |
| 公开(公告)号        | <a href="#">JP2013077011A5</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 公开(公告)日 | 2014-01-09 |
| 申请号            | JP2012245356                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 申请日     | 2012-11-07 |
| [标]申请(专利权)人(译) | 株式会社半导体能源研究所                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |            |
| 申请(专利权)人(译)    | 半导体能源研究所有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |            |
| [标]发明人         | 山崎舜平<br>高山徹<br>村上智史<br>木村肇                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |            |
| 发明人            | 山崎 舜平<br>高山 徹<br>村上 智史<br>木村 肇                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |            |
| IPC分类号         | G09F9/30 H01L27/32 H01L51/50 H05B33/14 H05B33/22 H01L21/336 H01L29/786                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |            |
| CPC分类号         | H01L27/3244 H01L27/3258 H01L27/3265 H01L51/5237 H01L2251/5315 H05B33/04 G02F1/133305<br>G02F1/136277 G02F1/1368                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |            |
| FI分类号          | G09F9/30.338 G09F9/30.365.Z H05B33/14.A H05B33/14.Z H05B33/22.Z H01L29/78.619.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |            |
| F-TERM分类号      | 3K107/AA01 3K107/AA05 3K107/BB01 3K107/BB08 3K107/CC21 3K107/CC36 3K107/DD90 3K107/EE03 3K107/FF15 5C094/AA21 5C094/AA31 5C094/BA03 5C094/BA27 5C094/BA43 5C094/DA13 5C094/HA08 5C094/JA08 5F110/AA14 5F110/BB01 5F110/CC02 5F110/DD01 5F110/DD02 5F110/DD03 5F110/DD15 5F110/DD17 5F110/EE01 5F110/EE04 5F110/EE14 5F110/EE22 5F110/EE23 5F110/EE28 5F110/FF01 5F110/FF02 5F110/FF09 5F110/GG02 5F110/HL02 5F110/HL03 5F110/HL12 5F110/HM15 5F110/HM17 5F110/NN02 5F110/NN05 5F110/NN22 5F110/NN23 5F110/NN24 5F110/NN27 5F110/NN28 5F110/NN34 5F110/NN35 5F110/NN36 5F110/NN71 5F110/NN72 5F110/QQ19 5F110/QQ23 |         |            |
| 优先权            | 2002143711 2002-05-17 JP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |            |
| 其他公开文献         | JP5619109B2<br>JP2013077011A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |            |

#### 摘要(译)

要解决的问题：提供尽可能抑制发光元件劣化的结构，并确保每个像素所需的足够的电容元件（电容器）。解决方案：在晶体管上依次堆叠第一钝化膜，第二金属层，平坦化膜，阻挡膜和第三金属层。设置在平坦化膜中的第一开口的侧面覆盖有阻挡膜，第二开口形成在第一开口内，并且第三金属层经由第一开口和第二开口连接到半导体。提供由晶体管的半导体，栅极绝缘膜，栅电极，第一钝化膜和第二金属层的叠层形成的电容器元件。